



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36477—2018

## 半导体集成电路 快闪存储器测试方法

Semiconductor integrated circuit—  
Measuring methods for flash memory

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施



国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 一般要求 .....	1
4.1 设备和条件 .....	1
4.2 电参数测试向量 .....	1
5 详细要求 .....	2
5.1 输出高电平电压和输出低电平电压 .....	2
5.2 输入高电平电压和输入低电平电压 .....	3
5.3 输入高电平电流和输入低电平电流 .....	5
5.4 输出高电平电流和输出低电平电流 .....	5
5.5 输出高电阻状态电流 .....	6
5.6 电源电流和漏电流 .....	6
5.7 传输时间 .....	7
5.8 建立时间和保持时间 .....	9
5.9 延迟时间 .....	11
5.10 有效时间(适用时) .....	11
5.11 存储器的特定时间 .....	11
5.12 存储单元 0 变 1 功能 .....	11
5.13 存储单元 1 变 0 功能 .....	12
5.14 特殊数据图形功能 .....	13
附录 A (资料性附录) 快闪存储器测试流程 .....	14

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、上海复旦微电子集团股份有限公司、深圳市中兴微电子技术有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司、复旦大学、中兴通讯股份有限公司。

本标准主要起草人:菅端端、陈大为、钟明琛、罗晓羽、冯光涛、倪昊、赵子鉴、董艺、田万廷、高硕、闵昊、刘刚。